

## 令和6年度退職教員の紹介

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 部局名    | 大学院工学系研究科・工学部  |  |
| 氏名     | 高木 信一  |   |
| 職名     | 教授   |   |
| 本学在職期間 | 平成15年10月～令和7年3月  |   |
| 所属     | 電気系工学専攻 電子材料物性工学講座   |   |
| 専門分野   | 半導体デバイス工学  |   |
| 略歴     | <p>昭和57年3月 本学工学部卒業</p> <p>昭和62年3月 本学大学院工学研究科博士課程修了、工学博士</p> <p>昭和62年4月 株式会社東芝総合研究所 (平成15年9月迄)</p> <p>平成5年8月 Stanford 大学滞在研究員 (平成7年3月迄)</p> <p>平成15年10月 本学大学院工学系研究科電子工学専攻電子材料物性工学講座、教授</p> <p>平成16年4月 本学大学院新領域創成科学研究科 基盤科学研究系 基盤情報学専攻 集積電子・光デバイス学大講座 半導体システム学分野、教授</p> <p>平成20年4月 本学大学院工学系研究科電子工学専攻 電子材料物性工学講座、教授</p> <p>平成21年4月 本学大学院工学系研究科電気系工学専攻 電子材料物性工学講座、教授</p>                                 |   |
| 研究内容   | <p>Takagi Shinichi. (共著) "On the Universality of Inversion-layer Mobility in Si MOSFET's (Part D) Effect of Substrate Impurity Concentration.", <i>IEEE Transaction on Electron Devices</i>, 41(1994): 2357-2362.</p> <p>Takagi Shinichi. (共著) "Carrier-transport-enhanced channel CMOS for improved power consumption and performance.", <i>IEEE Trans. Electron Devices</i>, 55 (2008): 21-39.</p> |   |